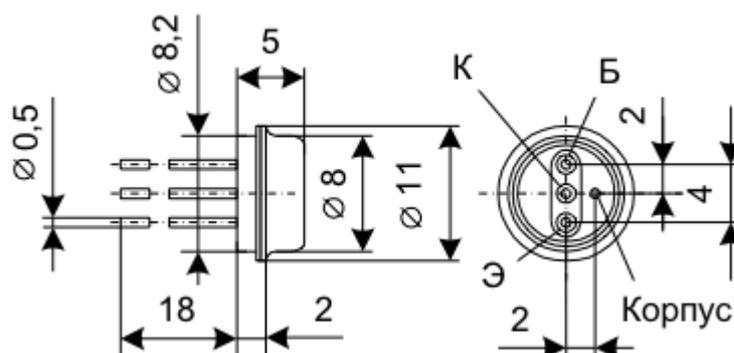


1Т313Б

Транзисторы германиевые диффузионно-сплавные структуры р-п-р универсальные. Предназначены для применения в усилителях высокой и сверхвысокой частот и переключающих устройствах. Выпускаются в металлоглазном корпусе с гибкими выводами. Тип прибора указывается на корпусе.

Масса транзистора не более 2 г.

Технические условия: ЖКЗ.365.161 ТУ.



Основные технические характеристики транзистора 1Т313Б:

- $h_{21Э}$ - Статический коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала: 20...80;
- C_k - Емкость коллекторного перехода при $U_{кб} = 5$ В: не более 2,5 пФ;
- t_k - Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте: не более 40 пс;
- $f_{гр}$ - Граничная частота коэффициента передачи тока: не менее 450 МГц;
- $I_{кбо}$ - Обратный ток коллектора при $U_{кб} = 12$ В: не более 5 мкА;
- $U_{кб}$ - Постоянное напряжение коллектор-база: не более 12 В;
- $U_{кб и}$ - Импульсное напряжение коллектор-база: не более 20 В;
- $U_{кэ}$ - Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{бэ} = 500$ Ом: не более 12 В;
- $U_{эб}$ - Постоянное напряжение эмиттер-база: не более 0,7 В;
- $I_{k max}$ - Максимально допустимый постоянный ток коллектора: 50 мА;
- $P_k max$ - Постоянная рассеиваемая мощность коллектора: 100 мВт.